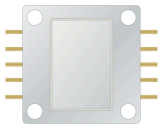
8000–12000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 46 dBm (typisch)

LCI-PA-8000-12000-PS46T · 8000–12000 MHz · GaN Gehäuster Leistungsverstärker.



Kennwerte der RF-Tabelle: PSAT 46 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 24 dB (typisch); PAE 37 % (typisch). RF-Prüfbedingungen: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 22 dBm; PW = 100 µs; D = 10%.

FPC1515-10

Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 5

RFin: 3

Vd: 6, 10

RFout: 8

NC: 2, 4, 7, 9

Gehäuseabmessungen: 15.24 × 15.24 × 1.4 mm.

RF-Kennwerte

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 22 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	f	8000	-	12000	MHz
Sättigungsausgangsleistung	-	-	46	-	dBm
Leistungsverstärkung	-	-	24	-	dB
Leistungsaddierte Effizienz	-	-	37	-	%
Welligkeit der Leistungsverstärkung	-	-	-	±0.5	dB

DC-Bias und Strom

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Drainspannung	-	-	-	-	28	V
Gatespannung	-	-	-	-	[-3.2, -2.2]	V

Grenzwerte

Grenzwerte; keine Sollwerte für den Normalbetrieb.

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Drain-Source-Spannung	-	-	-	32	V
Minimale Gate-Vorspannung	-	-5	-	-	V
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Maximale Eingangsleistung	-	-	-	27	dBm

Gehäuseabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Gehäuseabmessungen	15.24 × 15.24 × 1.4	mm

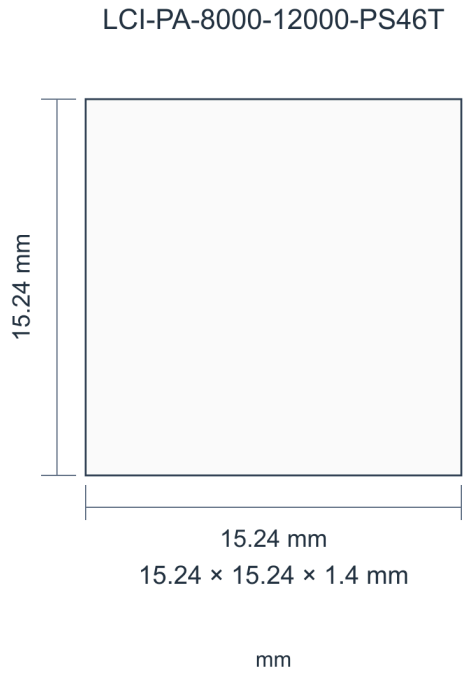
Aktueller Publikationsstand · 1.8 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.7.

Integrationshinweise

FPC1515-10 Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 5 RFin: 3 Vd: 6, 10 RFout: 8 NC: 2, 4, 7, 9

Mechanische Maßzeichnung

Teilzeichnung mit bestätigten Abmessungen in mm. Für die Montage ist der vollständige Montageplan erforderlich.

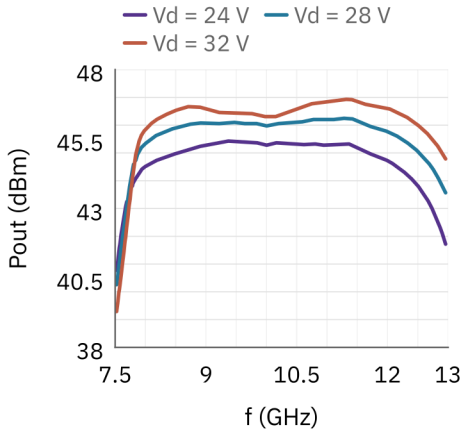


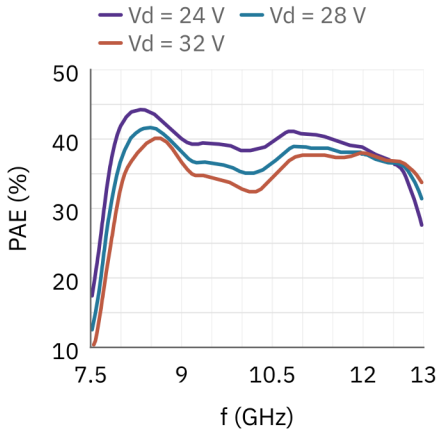
Kennlinien

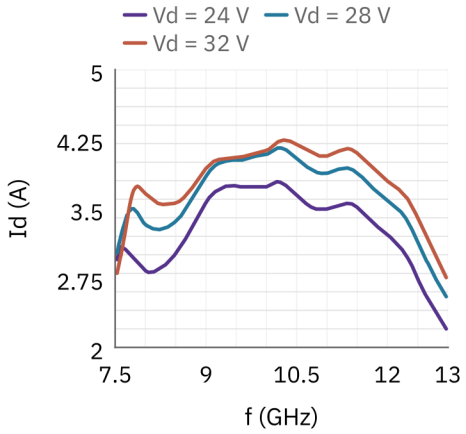
Für jedes Diagramm gelten die jeweils angegebenen Betriebsbedingungen.

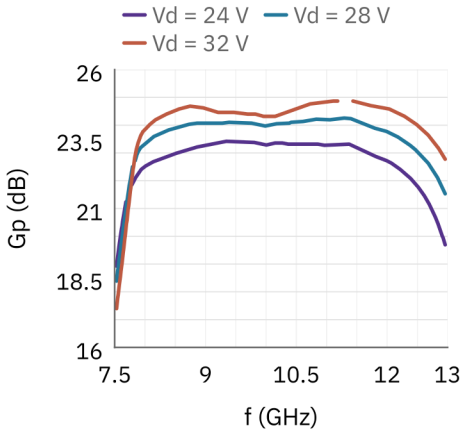
Ausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Drainstrom; Leistungsverstärkung.

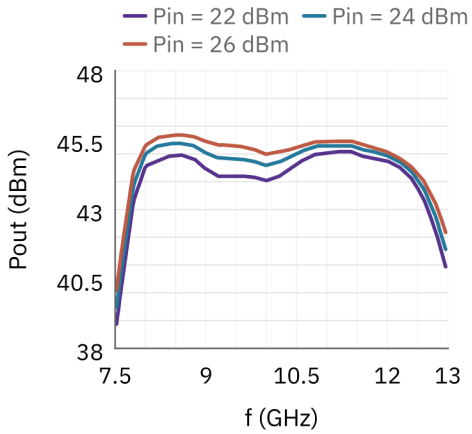
Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte. Die ersten vier Diagramme gelten für Pulsbetrieb: PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 22 dBm; Vg = −2.4 V; Temp = +25 °C; Vd = 24/28/32 V gemäß Kurvenlegende. Die unteren Pout- und PAE-Diagramme gelten für CW: Vd = 28 V; Vg = −2.4 V; IDQ = 2.2 A; Temp = +25 °C; Pin = 22/24/26 dBm gemäß Kurvenlegende.

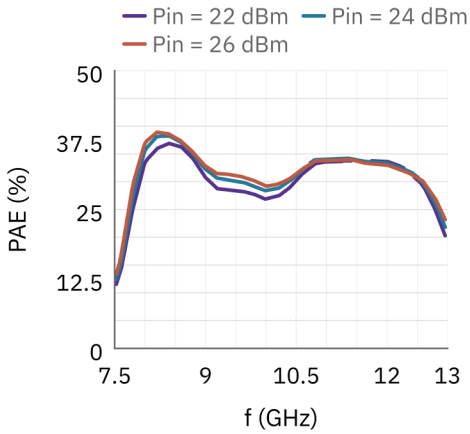


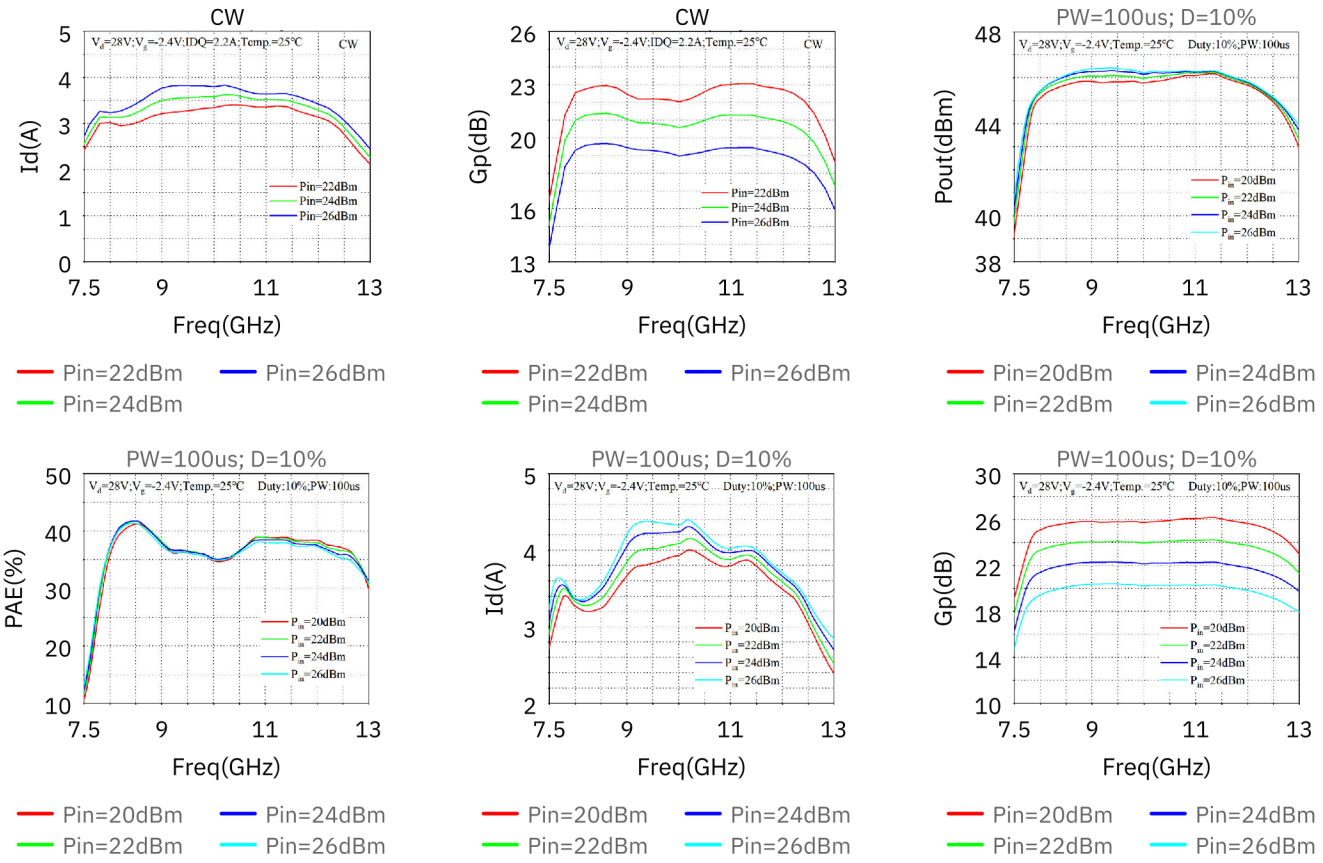












Ausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Drainstrom; Leistungsverstärkung. Vd = 28 V; Vg = -2.4 V; TA = 25 °C. Diagramme 1–2: CW; IDQ = 2.2 A; Pin = 22/24/26 dBm. Diagramme 3–6: PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 20/22/24/26 dBm.

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.